

Kurzbeschreibung

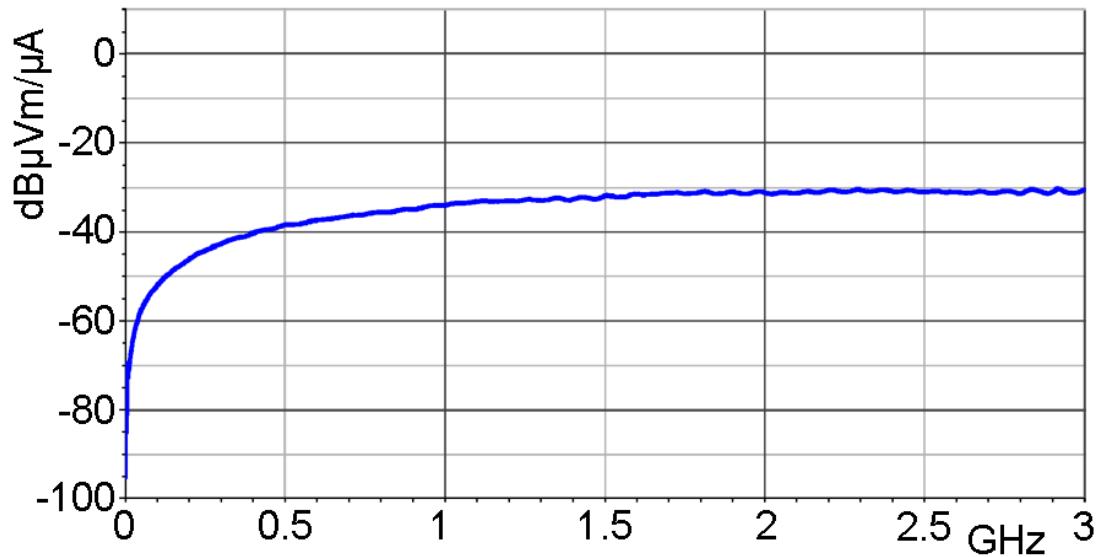
Die Nahfeldsonde RF-R 3-2 dient der Messung von HF-Magnetfeldern mit hoher Auflösung, die unmittelbar auf der Baugruppe, z.B. im Bereich um Pins und Gehäuse von ICs, Leiterzügen, Stützkondensatoren und EMV-Bauelementen.

Die RF-R 3-2 ist eine passive Nahfeldsonde. Sie besitzt den gleichen prinzipiellen Aufbau wie die Sonden RF-R 50-1 und RF-R 400-1. Die Auflösung der RF-R 3-2 ist jedoch wesentlich höher. Die H-Feldsonde ist für Messungen dicht an Bauelementen im Bereich hoher magnetischer Feldstärken geeignet. Für Messungen in größeren Abständen, wie sie mit der RF-R 400-1 und der RF-R 50-1 ausgeführt werden, ist sie nicht geeignet. Die Nahfeldsonde ist klein und handlich. Sie hat eine Mantelstromdämpfung und ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50Ω Eingang angeschlossen. Die H-Feldsonde besitzt intern keinen 50Ω Abschlusswiderstand.

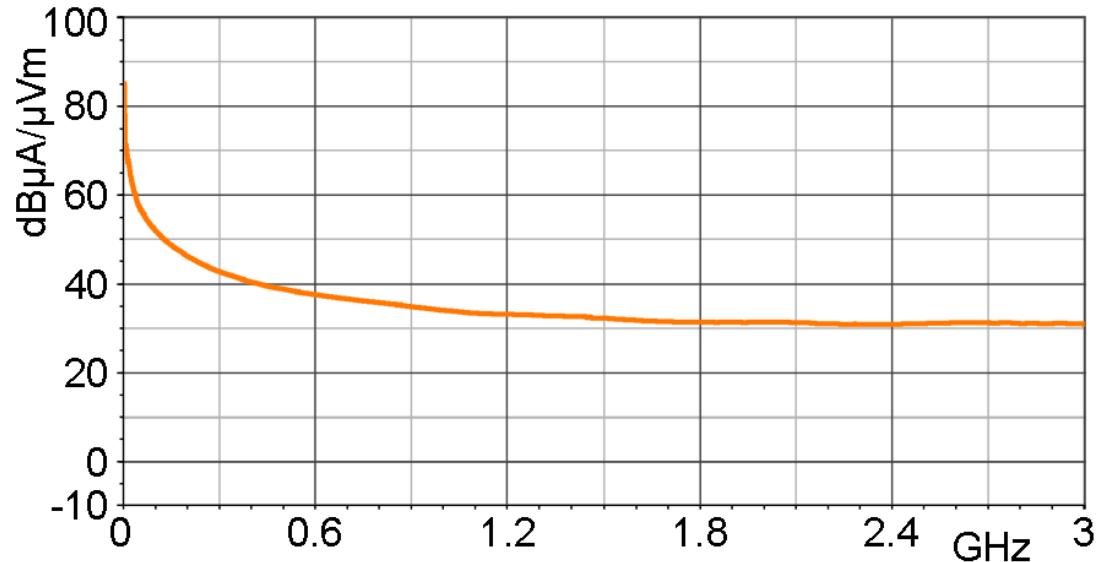
Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 3 GHz
Auflösung	$\approx 1 \text{ mm}$
Maße Sondenkopf:	$\varnothing \approx 3 \text{ mm}$
Anschluss - Ausgang	SMB, male, jack
Gewicht	15 g

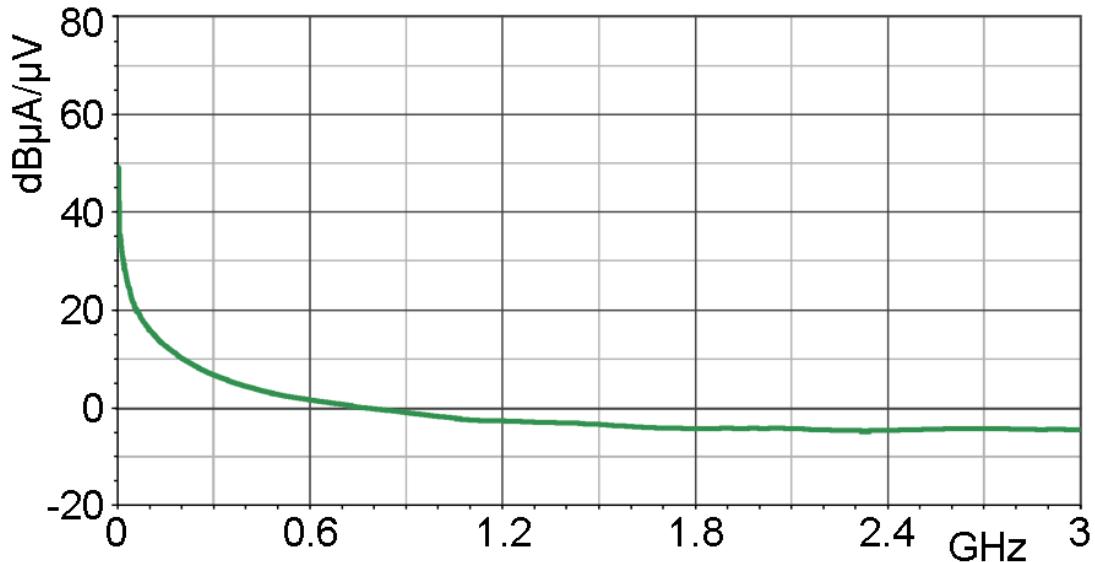
Frequenzgang [$\text{dB}\mu\text{V}$] / [$\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$]



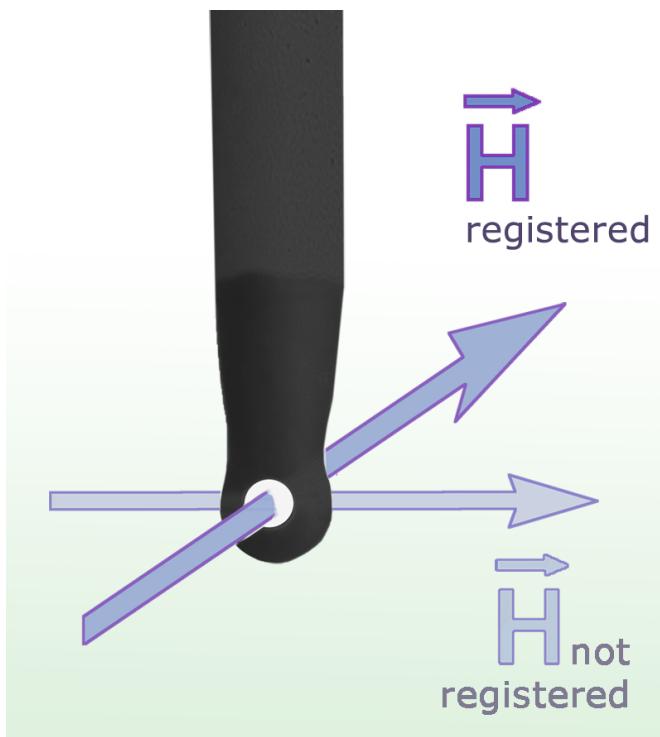
Korrekturkurve H-Feld [$\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$] / [$\text{dB}\mu\text{V}$]



Korrekturkurve Strom [$\text{dB}\mu\text{A}$] / [$\text{dB}\mu\text{V}$]



Messprinzip



RF-R 3-2

H-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

LANGER
EMV-Technik

Sondenkopf

